

The Data Book Project

DatasheetArchive.com has launched an ambitious effort to digitize thousands of obsolete data books and technical manuals, making them searchable via the DatasheetArchive website.

Scroll down to see the scanned document.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)															電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)										外 形	備 考
				V _{CB0} (V)	V _{EB0} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CB0} 最大値		直 流 又 は パ ル ス h _{FE}			バ イ ア ス		h _{fe}	h _{ie}	h _{ie} * (Ω)	h _{re}	h _{re} * (×10 ⁻⁴)	h _{oe}	h _{oe} * (μT)	f _{αβ} f _T * (Mc)	C _{ob} (pF)	τ _{bb} h _{ie(rea)} * (Ω)					
									μA	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)	h _{fb} *											h _{ib} *				
2SC1901	富士通	RF	Si.EP	25	3	20	200	175	0.1	12	150	8	5							1400*	1.2	40*	84C							
" 1902	"	"	"	40	3	300	500	175	0.1	35	80	14	55							650*	2.8	25*	84C							
" 1903	"	AF.RF	"	150	5	50	1W	150	1	140	150	5	10	5	-10					130*	2	70*	328							
" 1904	"	"	"	150	5	50	1W	150	1	140	150	5	10	5	-10					130*	2	70*	328							
" 1905	松下	PA	Si.TP	350	7	200	15W (T _c =25°C)	150	10	300	100	10	50	30	-20					45*	7.5	10	268							
" 1906	日立	RF.Conv.	Si.EP	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	V _{osc} = 550mV (f = 275MHz, V _{CE} = 9V, I _C = 7mA)				1000*	1	C _{rss} * 10pS	138							
" 1907	"	Osc.RF	"	30	2	50	300	125	0.5	10	>40	10	10	10	-10	V _{osc} = 630mV (f = 930MHz, V _{CE} = 10V, I _C = 10mA)				1100*	1	C _{rss} * 10pS	138							
" 1908	ソニー	RF	Si.E	30	4	30	500	120	1	25	80	6	1	6	-1					200*	2	C _{rss} * 25pS	138	2SA925 とコンパリ						
" 1909	日電	PA	"	75	4	3A	10W (T _c =25°C)	150	10	40	60	10	500	10	-150	P _o = 5.5W (f = 27MHz, V _{CE} = 12V, P _i = 0.2W)				160*	50	4	268							
" 1910	東芝	Diff	Si.EP	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	50	5	-30	ΔV _{BE} < 30mV, γΔV _{BE} < 0.2mV/°C (3V, 50mA)				7000*	1.1	15*	282A							
" 1911	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	ΔV _{BE} < 15mV, γΔV _{BE} < 0.1mV/°C (5V, 10mA)				6500*	0.66	15*	282A							
" 1912	"	"	"	20	2	30	150/unit	175	0.1	10	80	5	10	5	-10	ΔV _{BE} < 15mV, γΔV _{BE} < 0.1mV/°C (5V, 10mA)				6500*	0.66	15*	282R							
" 1913	松下	RF	"	150	5	1A	15W (T _c =25°C)	150	10	130	150	10	150	10	-50					120*	20	3k	268							
" 1914	三菱	AF.RF	"	90	5	50	200	125	0.1	50	250-1200	6	1	6	-1					150*	1.8		138B							
" 1915	"	"	"	120	5	50	800	135	1	100	150-800	10	10	10	-10					200*	2.3		242	2SA905 とコンパリ						
" 1916																														
" 1917																														
" 1918																														
" 1919	三菱	LN	Si.EP	50	5	30	200	125	0.1	50	250-1200	6	1	6	-1	NF = 0.9dB (5V, 100μA, 10Hz)				150*	1.9		138B							
" 1920	東芝	Diff	"	15	2	80	200/unit	175	0.1	5	75	3	30	5	-30	ΔV _{BE} < 30mV, γΔV _{BE} < 0.2mV/°C (3V, 50mA)				7000*	1.1	15*	282B							
" 1921	日立	RF	Si.T	250	5	50	600	150	1	120	30-300	6	10	6	-10					130*	3	25*	251							
" 1922	"	SW	"	1500	6	2.5A	50W (T _c =25°C)	150	10	600				5	-400	t _r < 1μS				5*	90	15	102	水平偏向用						
" 1923	東芝	RF.Conv. Mix.Osc	Si.EP	40	4	20	100	125	0.5	18	40-200	6	1	6	-1	NF = 2.5dB (100MHz)				550*	C _{re} 0.7	C _{rss} * < 30pS	138							
" 1924	日電	Diff.SW	Si.E	20	3	50	300	200	0.1	10	30-300	5	10	5	-15					3000*	C _{re} 1.1		309B	2素子複合						
" 1925	"	"	"	20	3	50	300	200	0.1	10	30-300	5	10	5	-15	h _{FE1} /h _{FE2} = 0.8-1.0 ΔV _{BE} < 10mV (5V, 10mA)				3000*	C _{re} 1.1		309A	2素子複合						
" 1926	"	"	"	30	3	50	200/unit	200	0.05	15	80	10	10	10	-10	h _{FE1} /h _{FE2} = 0.8-1.0				2000*	C _{re} 1.1		309B	2素子複合						
" 1927	"	"	"	30	3	50	300	200	0.05	15	80	10	10	10	-10					2000*	C _{re} 1.1		309A	2素子複合						
" 1928																														
" 1929	松下	PA	Si.P	300	6	400	25W (T _c =25°C)	150	10	300	150	5	100	10	-100					80*	12	15	268							
" 1930	富士通	RF	Si.EP	16	3	30	150	175	0.1	10	80	3	10	6	-20					8000*	0.3	30*	284							